



连接器 > 接口插槽 > 内存插槽 > SO DIMM 插槽 > DDR4 SO DIMM Sockets



DRAM 类型: 小型 (SO)

堆叠高度: 9.2 mm [.362 in]

模块方向: 直角

位数: 260

中心线 (间距) : .5 mm [.02 in]

[所有 DDR4 SO DIMM Sockets \(39\)](#)

产品特性

产品类型特性

连接器和端子端接到	印刷电路板
连接器系统	缆到板
DRAM 类型	小型 (SO)

结构特性

钥匙数	1
行数	2
模块方向	直角
位数	260

电气特征

DRAM 电压	1.2 V
---------	-------

信号特征

SGRAM 电压	1.2 V
----------	-------

主体特性

固定柱位置	两端
固定柱材料	不锈钢



插销材料	高温热塑塑料
模块钥匙类型	右偏移
弹射器类型	锁定
弹射器位置	两端
连接器外形	高

接触件特性

端子额定电流（最大值）	.5 A
端子底板材料	镍
内存插槽类型	内存卡
端子基材	铜合金
PCB 端子端接区域电镀材料	镀金
端子接触部电镀材料	金 (Au)
端子接合区域电镀材料厚度	.254 μm[10 μin]

端接特性

插入种类	凸轮
PCB 端接方法	表面贴装

机械附件

连接器安装类型	板安装
PCB 安装固定类型	焊钉
接合对准类型	反向键控
PCB 安装固定	带有

壳体特性

壳体颜色	黑色
外壳材料	高温热塑塑料
中心线（间距）	.5 mm[.02 in]

尺寸

堆叠高度	9.2 mm[.362 in]
行间距	8.2 mm[.322 in]

使用环境

工组温度范围	-55 – 85 °C[-67 – 185 °F]
--------	---------------------------

操作/应用

电路应用	电源
------	----



行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装数量	500
封装方法	卷带包装

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不在合规性范围内
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	回流焊接可达到 260°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件





该系列中的其他产品 | [DDR4 DIMM](#)



[DIMM 插槽\(25\)](#)

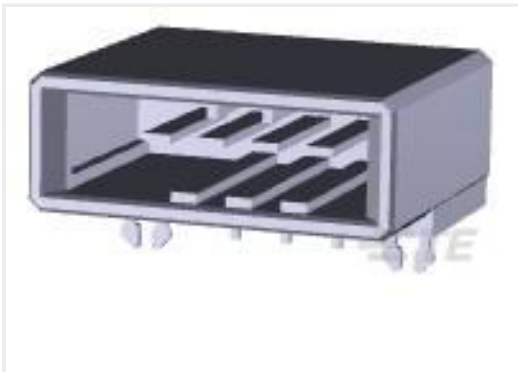


[SO DIMM 插槽\(39\)](#)

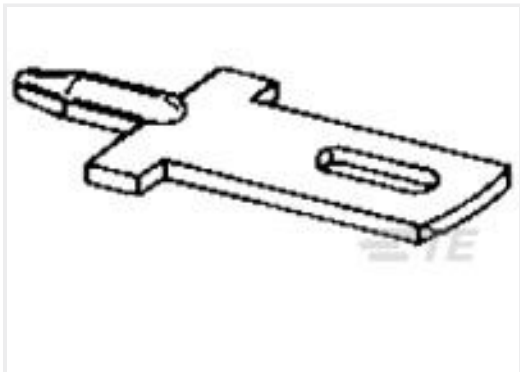
客户还购买了



TE 产品编号244837-E
[SMCQ 26 M AB VV 8-13 CL * H007 137 E005](#)



TE 产品编号1-178294-2
[DYNAMIC D3100 HDR ASY 4P H K/X](#)



TE 产品编号735187-2
[110 FASTON TAB TPBR](#)



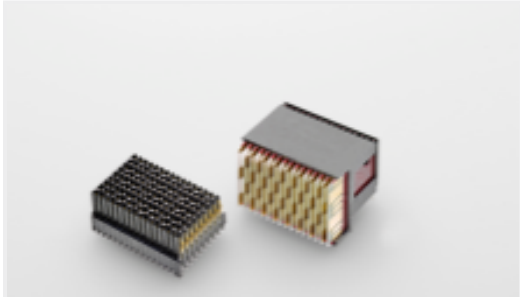
TE 产品编号2-2013310-1
[EMBOSS TAPE DDR3 204P 9.2H STD](#)



TE 产品编号2065883-1
[Zd Plus, 3 pair receptacle ass](#)



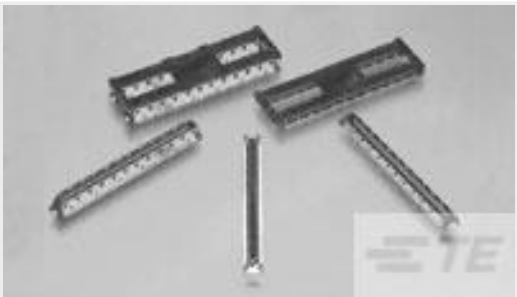
TE 产品编号2132500-1
[IMP100S,R,RA3P6C,UG,39](#)



TE 产品编号2302318-1
[RA ASSY, 7Rw, Left Half, MULTIGIG RT 2-S](#)



TE 产品编号2309407-3
[DDR4 SODIMM 260P 4.0H STD](#)



TE 产品编号3-6318490-6
[.5FHR04H,220,S,GIG,08/Sn,HT,NSYes](#)



TE 产品编号2299805-1
[NRW BACK PLATE ASSY,SOCKET P0, STUD6.8MM](#)

文档

产品图纸

[DDR4 SODIMM 260P 9.2H RVS](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

[3D](#)



下载查看

[ENG_CVM_CVM_2309414-3_1.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2309414-3_1.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2309414-3_1.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本